

反应离子刻蚀机

SAMCO RIE-1C

一、简介:

RIE-1C是一种紧凑的反应离子刻蚀系统。该系统是洁净室空间有限的实验室的理想解决方案，其设计可优化刻蚀速率、均匀性和选择性，尤其适合去除IC失效分析中的钝化层。

RIE-1C是一种氟基蚀刻系统，也可用于蚀刻硅基薄膜、难熔金属、金属硅化物和旋涂玻璃。配方设置完成，按一下按钮就可以开始完整的基板/设备处理。



二、应用:

- 1、刻蚀钝化材料如氮化硅、二氧化硅和氧氮化硅。
- 2、金属间介电层的刻蚀及剖面调整。
- 3、失效分析用集成电路板上残留

三、特征:

- 1、设定好工艺配方后“一键式”操作。
- 2、可处理一片4英寸晶片或多枚切片。
- 3、工艺完成时响铃通知。

仪准科技(香港)有限公司

Advanced Technology Co., Limited

TEL:021-34638926 FAX:021-64051950

Email:cypher_wang@adv-hk.com <http://www.adv-hk.com>



- 封装材料的刻蚀。 4、安全设施以保护操作员和设备。
- 4、光刻胶和聚酰亚胺的刻蚀。 5、紧凑式设计。
- 5、硅、多晶硅、难熔金属、硅化金属、旋涂玻璃等的刻蚀。 6、小体积可节省空间。

四、主要参数规格：

反应室	石英, Ø212 mm
上下电极	Ø120mm、水冷
射频功率	13.56MHz, 最大200W晶体振荡, 手动匹配
进气管	2条
压力测量	隔膜表 (0~2.66x 10 ² Pa)
真空系统	干泵 (500L/min)
尺寸	主机: 400毫米 (宽) x 440毫米 (深) x 325毫米 (高) 支架: 400 mm (宽) x 620 mm (深) x 798 mm (高)

五、设施要求：

工艺气体	0.1 MPa (G), 50 ml/min
氮气气体	0.1 MPa (G)
水冷	> 2 L/min

仪准科技 (香港) 有限公司

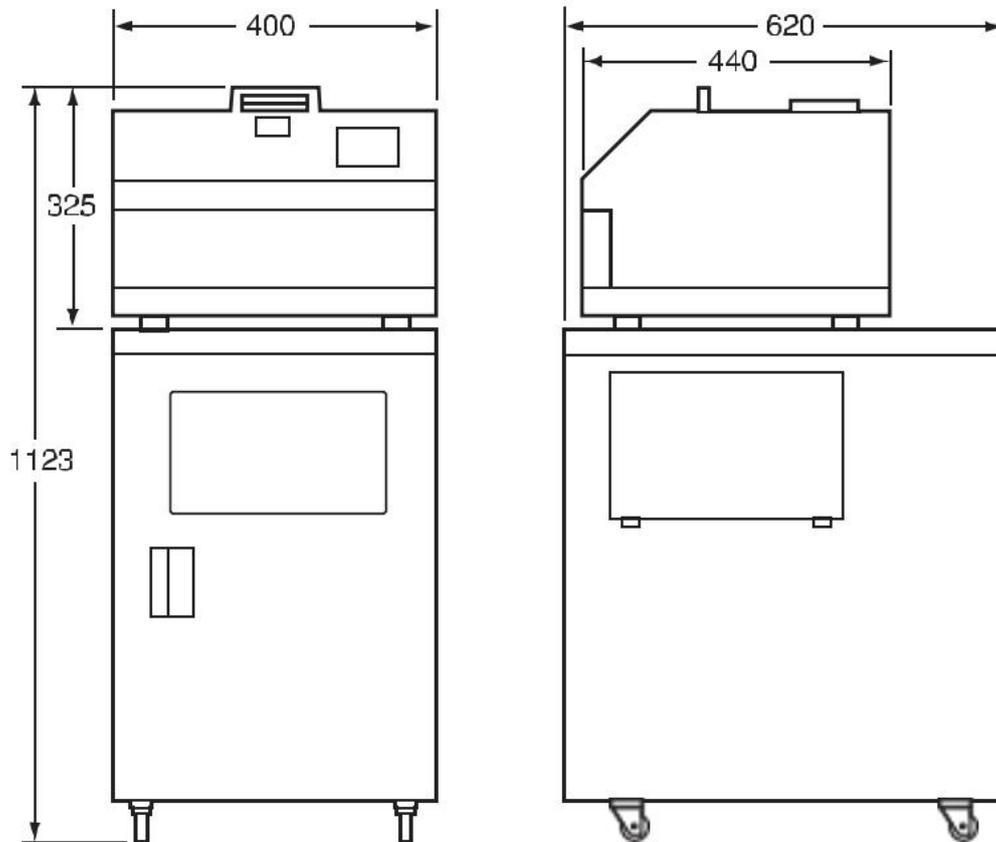
Advanced Technology Co., Limited

TEL:021-34638926 FAX:021-64051950

Email:cypher_wang@adv-hk.com <http://www.adv-hk.com>

电源

AC 100 V, 1-phase, 15 A



*** All measurements are in mm.
Dry pump is externally located.**

仪准科技(香港)有限公司

Advanced Technology Co., Limited

TEL:021-34638926 FAX:021-64051950

Email:cypher_wang@adv-hk.com <http://www.adv-hk.com>